



2SC1741S (3DG1741S)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于中功率放大。

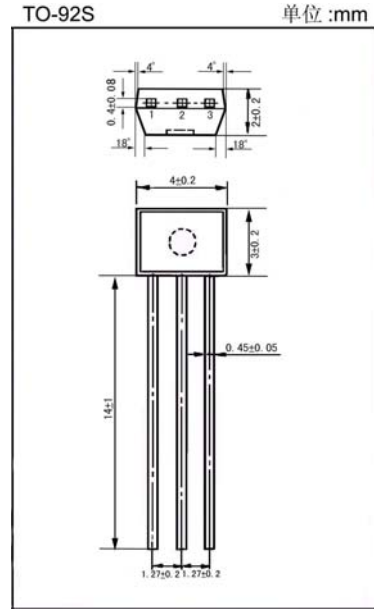
Purpose: Medium power transistor.

特点:电流大,饱和压降低。

Features: High I_C , Low $V_{CE(sat)}$.

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	40	V
V_{CE0}	32	V
V_{EB0}	5.0	V
I_C	500	mA
P_C	200	mW
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



引脚: 1. E 2. C 3. B

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=100\ \mu\text{A}$	$I_E=0$	40			V
V_{CE0}	$I_C=1.0\text{mA}$	$I_B=0$	32			V
V_{EB0}	$I_E=100\ \mu\text{A}$	$I_C=0$	5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=20\text{V}$	$I_E=0$			1.0	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=4.0\text{V}$	$I_C=0$			1.0	μA
h_{FE}	$V_{CE}=3.0\text{V}$	$I_C=100\text{mA}$	120		560	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}$	$I_B=50\text{mA}$			0.4	V
f_T	$V_{CE}=5.0\text{V}$	$I_E=-20\text{mA}$	$f=100\text{MHz}$	250		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$	$I_E=0$	$f=1.0\text{MHz}$	6.0		pF

h_{FE} 分档/ h_{FE} classifications: Q:120~270 R:180~390 S:270~560



2SC1741S (3DG1741S)

